

证券代码：300656

证券简称：民德电子



**深圳市民德电子科技股份有限公司
2021年度向特定对象发行A股股票
募集资金使用可行性分析报告**

二〇二一年七月

一、本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行 A 股股票募集不超过 50,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟募集资金投入金额
1	碳化硅功率器件的研发和产业化项目	39,824.00	28,000.00
2	适用于新型能源供给的高端沟槽型肖特基二极管产能的提升及技术改进项目	19,732.00	12,000.00
3	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00
合计		69,556.00	50,000.00

在本次向特定对象发行股份募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析

（一）碳化硅功率器件的研发和产业化项目

1、项目基本情况

项目名称	碳化硅功率器件的研发和产业化项目
实施主体	公司控股子公司——广微集成技术（深圳）有限公司
项目总投资	39,824.00 万元
项目建设内容	本项目拟通过与晶圆代工厂共同投入资源合作建立碳化硅晶圆生产专线，主要从事面向新型能源供给的 600V-1700V 碳化硅肖特基二极管、碳化硅 MOSFET 等产品的设计研发和产业化，产品主要应用于光伏逆变、电源无功补偿、汽车电子等领域，形成 6 英寸碳化硅晶圆年产能 3.6 万片
项目建设周期	2.5 年

2、项目建设的必要性

（1）新能源革命对功率半导体产业发展提出更高要求

国家“碳达峰、碳中和”战略所引发的新能源革命，将推动光伏、风能等清洁能源以及储能设备等新能源相关基础设施的大量建设，而新能源基础设施建设的高压、高频、高功率应用场景对功率半导体器件发展提出了更高要求。

硅材料属于基础性半导体材料，而碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等宽禁带半导体材料属于高能半导体材料，也被业内称为第三代半导体材料。以第三代半导体材料制作的功率器件相比传统硅基功率器件，具有能效高、损耗小、小型化的特点，在高压、高频、高功率的新能源基础设施建设中有广阔的应用前景。

因此，为顺应新能源革命对功率半导体产业发展提出的更高要求，公司有必要开拓具有高能属性的第三代半导体产业。

（2）助力国家第三代半导体产业国产化进程

全球第三代半导体产业虽有较长时间的研究历程，但在近年来才逐步实现产业化推广，并在越来越多适应于高压、高频、高功率的领域得到广泛应用，如光伏、风能、新能源汽车、充电桩、高铁、5G 等应用领域。

目前，美、欧、日等国家在第三代半导体产业链技术成熟度明显领先于中国。以碳化硅功率器件产业链为例：原材料方面，碳化硅功率器件最主要原材料为碳化硅衬底，在成本中占比约 50%，60%以上碳化硅衬底产自美国 Cree 公司，剩余约 30%以上碳化硅衬底产自其他美、欧、日半导体材料公司；生产制造方面，可以实现碳化硅功率器件大规模量产的品牌企业也主要是美国 Cree、德国英飞凌、美国安森美、日本罗姆、瑞士意法半导体等国外先进科技企业；市场应用方面，国内市场约 80%的碳化硅功率器件依赖于进口。

鉴于全球第三代半导体产业仍处于产业化的起步快速成长阶段，国内企业技术水平与国际先进企业差距相对有限，有望通过加大投入逐步缩小与国际先进企业技术差距；此外，第三代半导体产业链实现国产化，对保障国家新能源革命战略顺利推进至关重要。

(3) 丰富公司功率半导体产品线，提升公司核心竞争力

公司在功率半导体领域有着清晰的技术路线和产品路线。目前产品线以硅基功率器件为主，包括肖特基二极管、超级结 MOSFET、快恢复二极管、SGT-MOSFET 等。公司以硅基功率器件为基本盘，积极布局第三代半导体相关产品，满足功率器件往更高的功率密度、更高的封装密度方向发展，有助于丰富公司功率半导体产品线，进一步提升公司在功率半导体产业的核心竞争力。

3、项目建设的可行性

(1) 国家政策大力支持第三代半导体产业发展

近年来，国家大力支持第三代半导体产业发展，国家及各部委、各地方陆续发布针对第三代半导体产业发展的支持政策，主要如下：

时间	政策名称	相关内容
2021 年 3 月	十四五规划和 2035 年远景目标纲要	加强原创性引领性科技攻关：集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展
2019 年 12 月	中共中央、国务院印发长江三角洲区域一体化发展规划纲要	纲要明确要求长三角区域加快培育布局第三代半导体产业，推动制造业高质量发展
2019 年 11 月	工业和信息化部关于印发重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）	对重点新材料首批次应用给予保险补偿，GaN 单晶衬底、功率器件用 GaN 外延片、SiC 外延片、SiC 单晶衬底等第三代半导体进入目录
2019 年 6 月	鼓励外商投资产业目录（2019 年版）	支持引进 SiC 超细粉体（纯度>99%）、高纯超细氧化铝微粉（纯度>99%）、高纯氮化铝（AlN）粉体（纯度>99%，平均粒径<1μm）等精密高性能陶瓷原料外资生产企业
2019 年 4 月	深圳市进一步推动集成电路产业发展行动计划（2019—2023 年）	前瞻布局，加快培育第三代半导体
2017 年 5 月	“十三五”交通领域科技创新专项规划	提出开展汽车整车、动力系统、底盘电子控制系统以及 IGBT、碳化硅、氮化镓等电力电子器件技术研发及产品开发和零部件、系统的软硬件测试技术研究测试评价技术规范体系研究

时间	政策名称	相关内容
2017 年 4 月	“十三五”材料领域科技创新专项规划	在总体目标、指标体系、发展重点等各方面均提出要大力发展第三代半导体材料
2016 年 8 月	“十三五”国家科技创新规划	启动一批面向 2030 年的重大项目，第三代半导体被列为国家科技创新 2030 重大项目“重点新材料研发及应用”
2015 年 5 月	中国制造 2025	明确提出要大力发展第三代半导体产业，要求 2025 年实现在 5G 通信、高效能源管理中的国产化率达到 50%；在新能源汽车、消费电子中实现规模应用，在通用照明市场渗透率达到 80%以上

国家政策的大力支持，将有力地推动我国第三代半导体产业的发展，为本项目实施提供了良好的政策环境。

（2）碳化硅功率器件市场持续快速增长

碳化硅的市场应用领域偏向 1000V 以上的中高电压范围，具有耐高压、耐高温、高频三大优势，比硅更薄、更轻、更小巧。

碳化硅功率器件市场目前处于产业化的起步阶段，但市场规模正在快速扩张。现阶段，限制碳化硅功率器件推广的主要因素包括碳化硅原材料成本高、产业链成熟度有待提升、下游应用有待进一步开发。伴随国内外碳化硅产业链日趋成熟，规模和技术不断提升，成本持续下降，下游新的应用不断开发，碳化硅即将迎来爆发式增长。

根据 IHS 统计数据，2018 年碳化硅功率器件市场规模约 3.9 亿美元，受新能源汽车庞大需求的驱动，以及光伏、风能和充电桩等领域对于效率和功耗要求提升，预计到 2027 年碳化硅功率器件的市场规模将超过 100 亿美元。

（3）碳化硅功率器件已初具国产化供应链基础

在国家的大力支持和国内先行企业的不断探索下，我国碳化硅功率器件已初具国产化供应链基础，为碳化硅功率器件进一步国产化和供应链自主可控奠定了较好的产业链基础。

碳化硅功率器件产业链各环节国内部分代表企业列示如下：

碳化硅功率器件 产业链环节	国内部分代表企业
设备	北方华创、中微公司、华峰测控等
衬底	天科合达、山东天岳、德清州晶等
外延	瀚天天成、东莞天域、天科合达等
设计	闻泰科技、斯达半导、士兰微等
制造	闻泰科技、中车时代电气、华润微等
封测	长电科技、华天科技、士兰微等

(4) 公司拥有相关的技术储备，并已对碳化硅工艺平台完成了初步验证

公司控股子公司广微集成创始人谢刚博士及其研发团队长期从事硅基功率半导体及第三代半导体功率器件的研发及产业化工作，拥有丰富的技术储备，前期已与合作晶圆代工厂对碳化硅工艺平台进行了初步验证，为后续进行试生产和量产奠定了良好的基础，对本项目的顺利实施提供了技术保障。

4、项目投资计划

本项目总投资 39,824.00 万元，拟使用募集资金 28,000.00 万元，项目具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	总投资金额	募集资金投入金额	募集资金投入占比
1	硬件设备购置费	28,024.00	28,000.00	99.91%
2	研发支出	3,000.00	-	-
3	基本预备费	2,800.00	-	-
4	铺底流动资金	6,000.00	-	-
合计		39,824.00	28,000.00	70.31%

5、项目经济效益

本项目运营期内，达产后可实现年均营业收入 6.05 亿元，年均净利润 0.53 亿元，项目预期效益良好。

6、项目备案情况

本项目的立项备案及环评批复正在办理中。

（二）适用于新型能源供给的高端沟槽型肖特基二极管产能的提升及技术改进项目

1、项目基本情况

项目名称	适用于新型能源供给的高端沟槽型肖特基二极管产能的提升及技术改进项目
实施主体	公司控股子公司——广微集成技术（深圳）有限公司
项目总投资	19,732.00 万元
项目建设内容	本项目拟通过与晶圆代工厂共同投入资源合作建立晶圆生产专线，主要投向面向新型能源供给的 45V-150V 高效低导通压降硅基沟槽型肖特基二极管的产能提升，以及 200V-300V 高压肖特基二极管的研发和产业化，产品主要应用于光伏接线盒、各种拓扑电源等领域，新增 6 英寸硅基晶圆年产能 42 万片
项目建设周期	2 年

2、项目建设的必要性

（1）新能源蓬勃发展带动上游功率半导体器件需求增长

习近平总书记在 2021 年 3 月 15 日的中央财经委员会第九次会议上强调，实现“碳达峰、碳中和”是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。能源供给的多样化与否直接涉及国家安危。“碳达峰、碳中和”战略将我国能源体系从传统上较弱的“资源属性”转变成了较强的“制造属性”。我国功率半导体产业势必伴随着能源系统和动力系统在中国“碳达峰、碳中和”的“双碳”战略目标导向下发生深刻而长远的历史性变革和国产化机遇。传统的能源系统和动力系统将从“碳基时代”迈向“硅基时代”，从而在能源生产侧实现“清洁替代”，在能源消费侧实现“电能替代”。以电为中心，以电力系统为平台，以清洁化、电气化、数字化、标准化为方向，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，这将会直接推进社会格局的重塑再构和人类文明的跨代演进。

功率半导体广泛应用于光伏、风能、储能、新能源汽车等新能源领域。根据国际能源署（IEA）预测，可再生能源将在 2025 年取代煤电近 50 年的统治地位，成为世界最主要的发电方式，可再生能源将供应世界近三分之一的电力，全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的 7%提升至 2040 年的 24%，太阳能将在 2040 年生产相当于 2019 年 13 倍的电力。此外，储能装置和新能源汽车产销

量也将保持快速增长。因此，受全球新能源市场蓬勃发展推动，功率半导体作为电子装置电能转换与电路控制的核心器件，其市场也将迎来长期快速增长。

(2) 功率半导体进口替代市场需求强烈

根据 IHS 统计数据，2019 年全球功率半导体市场规模达 403 亿美元，其中中国功率半导体市场占据全球 35% 以上的份额，为全球最大市场，但国产化率仍处于相对较低水平，尤其是中高端产品领域进口替代有着非常广阔的市场空间。

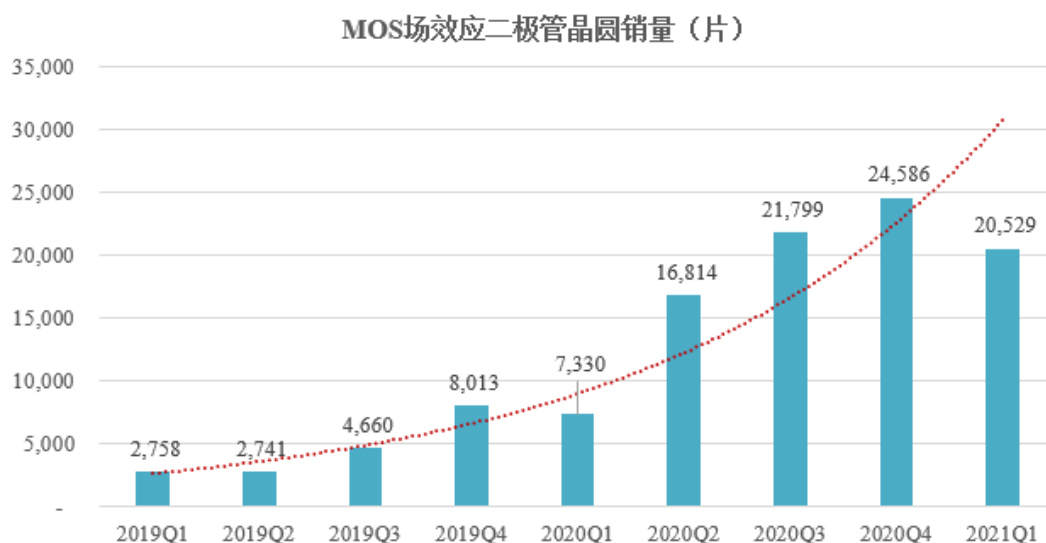
中国大陆功率半导体产业整体起步较晚，经过国家多年的政策扶持和国产厂商努力，国产功率半导体企业发展已取得了长足进步，但与国外品牌企业相比仍存在较大差距，国产功率半导体市场尚未形成稳定的竞争格局。伴随功率半导体国产化进一步推进，中国市场有望涌现一批世界级的功率半导体企业。

(3) 公司功率半导体订单远超目前产能负荷

MOS 场效应二极管（Mos Field Effect Rectifier, MFER）系公司控股子公司广微集成的核心产品，具体涵盖 100 多种规格型号。MOS 场效应二极管是一种新型的肖特基势垒二极管，相比于平面肖特基二极管来说，其 MOS 沟槽结构很好地抑制了肖特基表面势垒降低效应，使得其具有较高的击穿电压。在 45-300V 电压级别应用领域，沟槽型肖特基二极管相对于平面肖特基二极管具有很大的竞争优势，主要体现在其较低的导通压降，低的漏电流和好的高温特性，产品主要面向市场高端领域。

自 2019 年第四季度开始，广微集成核心产品 MOS 场效应二极管产销量开始稳步上升。随着产品系列的不断丰富和客户认可度的不断提高，MOS 场效应二极管的晶圆（6 英寸）销量从 2019 年初 1,000 片/月提升至目前约 8,000 片/月。根据在手订单情况，广微集成已通过设备合作与上游晶圆加工厂协商扩增产能，预计 2021 年第三季度 6 英寸晶圆产能扩增至 15,000 片/月，但仍远不能满足现有及潜在客户的订单需求，公司亟需通过协同上游晶圆代工厂进一步扩大晶圆代工产能，以持续满足客户订单需求。

2019 年至 2021 年第一季度，广微集成核心产品 MOS 场效应二极管分季度晶圆（6 英寸）销售情况如下：



（4）提升公司功率半导体产品市场占有率，增强公司核心竞争力

自公司 2020 年 6 月控股收购广微集成以来，公司通过为广微集成提供资金和信用平台支持，广微集成功率半导体产品产能持续提升，但相对于功率半导体千亿级的市场体量，广微集成产品目前市场占有率和品牌影响力仍较为有限。因此，通过持续投资扩产来提升公司功率半导体产能，有助于提升公司在功率半导体领域的市场占有率和品牌影响力，也有助于增强公司核心竞争力。

3、项目建设的可行性

（1）国家政策大力支持功率半导体产业发展

近年来，国家大力支持功率半导体产业发展，国家及各部委、各地方陆续发布针对功率半导体产业发展的支持政策，主要如下：

时间	政策名称	相关内容
2021 年 7 月	关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见（六部门印发）	1、提高优质企业自主创新能力。加大基础零部件、基础电子元器件、基础材料、基础工艺、集成电路等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用 2、充分发挥优质企业在增强产业链供应链自主可控能力中的中坚作用，组织参与制造业强链补链行动，做强长板优势，补齐短板弱项，打造新兴产业链条，提升产业链供应链稳定性和竞争力

时间	政策名称	相关内容
2021 年 3 月	十四五规划和 2035 年远景目标 纲要	聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平
2021 年 1 月	基础电子元器件 产业发展行动计 划（2021-2023 年）	实施重点产品高端提升行动，重点发展耐高温、耐高压、低损耗、高可靠半导体分立器件及模块等电路类元器件；实施重点市场应用推广行动，推动功率器件等高可靠电子元器件在高端装备制造市场的应用
2019 年 10 月	产业结构调整指 导目录（2019 年 本）	将包括电力电子器件在内的新型电子元器件制造列入“鼓励类”
2018 年 11 月	战略性新兴产业 分类（2018）	将与半导体相关的若干国民经济行业划分为战略性新兴产业，主要有新型电子元器件及设备制造、集成电路制造、半导体晶体制造、太阳能设备和生产装备制造、太阳能材料制造、高效节能专用设备制造等
2017 年 5 月	“十三五”交通 领域科技创新专 项规划	提出开展汽车整车、动力系统、底盘电子控制系统以及 IGBT、碳化硅、氮化镓等电力电子器件技术研发及产品开发和零部件、系统的软硬件测试技术研究及测试评价技术规范体系研究
2017 年 1 月	战略性新兴产业 重点产品和服务 指导目录	将金属氧化物半导体场效应管（MOSFET）、绝缘栅双极晶体管芯片（IGBT）、垂直双扩散金属-氧化物场效应晶体管（VDMOS）等列入战略性新兴产业
2016 年 8 月	“十三五”国家 科技创新规划	开展新型光通信器件、半导体照明、高效光伏电池、MEMS（微机电系统）传感器、柔性显示、新型功率器件、下一代半导体材料制备等新兴产业关键制造装备研发，提升新兴领域核心装备自主研发能力；以第三代半导体材料与半导体照明、新型显示为核心，推动跨界技术整合，抢占先进电子材料技术的制高点
2016 年 3 月	中华人民共和国 国民经济和社会 发展第十三个五 年规划纲要	支持新一代信息技术发展壮大，大力推进先进半导体等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点。推广半导体照明等成熟适用技术
2015 年 5 月	中国制造 2025	电力装备方面，突破大功率电力电子器件等关键元器件和材料的制造及应用技术，形成产业化能力

国家政策的大力支持，将有力地推动我国功率半导体产业的发展，为本项目实施提供了良好的政策环境。

（2）功率半导体市场容量大且长期持续增长

根据 IHS 统计数据，2019 年全球功率半导体市场规模达 403 亿美元，伴随光伏、风能、储能、新能源汽车等新能源产业快速发展，功率半导体市场有望保持长期持续增长。此外，中国大陆占全球功率半导体近四成市场份额，为全球最大市场，但国产化率仍处于较低水平，尤其是中高端功率器件 90% 仍要依赖进口，因此，中国功率半导体行业进口替代有着非常广阔的市场空间。

(3) 公司具备沟槽型肖特基二极管产品线长期技术路线储备

MOS 场效应二极管为广微集成目前最主要量产产品，具体涵盖 100 多种规格型号，是国内 MOS 场效应二极管产品系列较为齐全的厂商之一，其在 MOS 场效应二极管产品线方向有着长期技术路线储备和清晰的产品路线规划，产品性能已获得诸多行业品牌客户验证，已实现进口替代。

目前技术与国际厂商相比，广微集成 MOS 场效应二极管产品拥有良好的导通压降和器件漏电流的折中，特别在高温应用环境中表现出优异的可靠性。广微集成与国内晶圆代工厂合作，采用特色工艺流程，使得器件不仅具有极好的导通压降和反向漏电的折中优化、极好的抗静电能力，而且具有较高的性价比。广微集成目前可提供 45V-150V 全系列 MOS 场效应二极管产品，和国内同行相比，广微集成对该产品线的专注度较高，系列较为完整。公司在沟槽型肖特基二极管产品线方面的技术储备为本项目的实施提供了坚实的技术支撑。

(4) 公司 Smart IDM 模式为扩产供应链提供充分保障

高端功率半导体器件并无标准化产品，其器件参数的定义依赖于具体的应用领域。这种高度定制化的特色产品，需要产业链上下游的高度协同与合作。

从产业链组织形式来看，国外规模较大的功率半导体企业主要采用 IDM 模式，这样有利于其特色工艺的发挥和供应链的安全稳定；国内的功率半导体企业整体规模相对较小，少部分企业采用 IDM 模式，大部分企业采用 Fabless 模式，仅从事芯片的设计与销售，晶圆加工和产品封装则交由专业合作厂商完成。

公司致力于打造功率半导体的 Smart IDM 模式，即通过资本参股或控股的方式，打通功率半导体全产业链。在这种模式下，公司对产业链上下游各环节企业均保持足够影响力，但不谋求拥有。这种模式既保证了产业链上下游公司紧密合

作，以实现特色工艺和供应链的安全稳定，又使得产业链上各家公司保持了独立的组织架构、自主的产品发展规划、充分的市场竞争意识和广阔的国际化发展空间。

(5) 公司与晶圆代工厂合作共建产线模式已有成功实践

本次募集资金投资项目拟采用与晶圆代工厂合作共建专线模式，专线用于公司功率半导体器件的生产。公司控股子公司广微集成已有与晶圆代工厂合作共建产线的成功实践，为本次募集资金投资项目实施积累了宝贵经验。

4、项目投资计划

本项目总投资 19,732.00 万元，拟使用募集资金 12,000.00 万元，项目具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	总投资金额	募集资金投入金额	募集资金投入占比
1	硬件设备购置费	12,482.00	12,000.00	96.14%
2	研发支出	2,000.00	-	-
3	基本预备费	1,250.00	-	-
4	铺底流动资金	4,000.00	-	-
合计		19,732.00	12,000.00	60.81%

5、项目经济效益

本项目运营期内，达产后可实现年均营业收入 2.52 亿元，年均净利润 0.30 亿元，项目预期效益良好。

6、项目备案情况

本项目的立项备案及环评批复正在办理中。

(三) 补充流动资金项目

1、项目基本情况

本次募集资金中拟使用 10,000.00 万元用于补充流动资金。公司在综合考虑现有资金情况、实际运营资金需求缺口，以及未来战略发展需求等因素确定本次募集资金中用于补充流动资金的规模，整体规模适当。

2、补充流动资金的必要性和可行性

（1）公司业务规模不断增长导致对流动资金的需求进一步扩大

自上市以来，公司通过积极的业务拓展，目前已形成“条码识别业务+半导体设计与分销业务”的双产业布局。最近三年，公司业务规模持续保持较快增长，营业收入年均复合增长率达21.17%。随着业务规模和营业收入的不断增长，公司对营运资金的需求也随之扩大，公司亟需通过补充流动资金，缓解公司经营性资金不足的压力。

（2）巩固公司主营业务的发展，保障发展战略的实现

为产业长远和可持续发展考虑，公司构建了“条码识别+功率半导体”的双产业成长曲线，并确定了“深耕条码识别，聚焦功率半导体”的企业发展战略。目前，公司一方面需要强化现有产品的优势地位，另一方面需要面向市场需求积极布局前沿产品领域，持续加大研发投入，更好地促进研发投入的成果转化，不断丰富和优化公司的产品体系。在这种情况下，公司有必要预留充足的营运资金保障公司发展战略的实现，进一步巩固公司主营业务的发展。

（3）优化资产结构，增强公司抵御风险和可持续发展的能力

近年来，国际环境复杂多变，国内外行业竞争激烈，新型冠状病毒疫情对全球经济贸易的不利影响仍将持续，公司面临的外部环境不确定性因素正在增多。在国际环境复杂多变、国内外行业竞争激烈的局面下，危机与机遇并存。为了应对各种不确定因素，把握有利的发展机遇，公司有必要保持充足的营运资金。

通过本次发行补充流动资金，公司将有效增加营运资金的规模，可进一步优化公司资产结构，降低公司资金流动性风险，增强公司抵御风险和可持续发展的能力。

综上所述，通过本次发行募集资金中的10,000.00万元用于补充公司流动资金，可以满足公司未来业务发展的资金需求，增强持续经营能力，优化公司资产结构，提高公司抗风险能力，是公司经营和发展的客观需要，具有充分的合理性与必要性。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，顺应国家“碳达峰、碳中和”新能源战略及支持功率半导体国产化的产业政策，契合公司未来整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实力，对公司的发展战略具有积极作用。本次募集资金投资项目有助于优化公司业务结构，提升公司经营管理能力，提高公司盈利水平，并进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司资产总额与净资产额将同时增加，资金实力将大幅增强，进一步提升公司抗风险能力，为公司未来发展奠定良好基础。

本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅度增加；在资金开始投入募集资金投资项目后，投资活动产生的现金流出将有所增加；在募集资金投资项目建成运营后，公司经营活动产生的现金流量净额预计将得到提升。

本次发行完成后，公司总股本将有所增加，募集资金投资项目产生的经营效益在短期内无法迅速体现，因此公司的每股收益在短期内存在被摊薄的风险。本次募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持，将进一步增强公司的可持续发展能力。

四、本次发行股票募集资金运用的可行性分析结论

综上所述，本次募集资金使用用途符合公司整体战略发展规划，以及相关法律法规及产业政策的要求，具备必要性和可行性。本次募集资金投资项目建设有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 16 日